

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
فصل اول: مقدمه‌ای بر مفاهیم الکترونیک دیجیتال	
۱	مقدمه
۱	درسنامه (۱): سیگنال‌ها و مدارات منطقی
۱	منطق دودویی
۲	سیگنال‌های دودویی
۳	مدارات سوئیچینگ
۶	درسنامه (۲): تکنولوژی‌های منطقی
۶	خانواده مدارات دیجیتال
۷	معکوس‌کننده (وارونگر) دیجیتال
۸	نمودار مشخصه VTC و نقاط بحرانی
۹	دبایل کننده (بافر) دیجیتال و نمودار مشخصه VTC آن
۱۲	درسنامه (۳): ارزیابی مدارات الکترونیک دیجیتال
۱۲	حاشیه نویز (Noise Margine)
۱۳	توان مصرفی
۱۵	ظرفیت ورودی و ظرفیت خروجی
۱۶	تأخر انتشار
فصل دوم: دیودهای پیوندی و مدارات دیودی RDL	
۱۸	مقدمه
۱۸	درسنامه (۱): عملکرد دیودها
۱۸	دیودهای پیوندی و دیودهای شاتکی
۱۹	بایاس دیودها
۲۲	درسنامه (۲): مدارات RDL
۲۲	تکنولوژی مقاومت دیود (RDL)
۲۶	تکنولوژی RDL اصلاح شده
۲۹	دیودهای برش گر
فصل سوم: ترانزیستورهای دوقطبی (BJT) و مدارات DTL و RTL	
۳۰	مقدمه
۳۰	درسنامه (۱): عملکرد ترانزیستورها
۳۰	ساختار ترانزیستورهای BJT
۳۱	عملکرد ترانزیستورهای BJT
۳۴	درسنامه (۲): مدارات RTL
۳۴	تکنولوژی مقاومت - ترانزیستور (RTL)
۳۸	پارامترهای عملکردی تکنولوژی RTL
۴۴	درسنامه (۳): مدارات DTL
۴۴	تکنولوژی دیود - ترانزیستور (DTL)
۴۵	پارامترهای عملکردی تکنولوژی DTL

مدرسان شریف



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
فصل چهارم: مدارات تکنولوژی TTL و FCL	
۴۸	مقدمه
۴۸	درسنامه (۱): طراحی و تحلیل مدار پایه TTL
۴۸	طراحی تکنولوژی TTL بر پایه تکنولوژی DTL
۵۱	وارونگر پایه تکنولوژی TTL
۵۵	پارامترهای عملکردی تکنولوژی TTL
۵۸	درسنامه (۲): طراحی و تحلیل دروازه‌های ترکیبی TTL
۵۸	دروازه NAND تکنولوژی TTL
۵۹	دروازه AND تکنولوژی TTL
۶۱	دروازه NOR تکنولوژی TTL
۶۲	دروازه OR تکنولوژی TTL
۶۳	طراحی مدارات منطقی ترکیبی در تکنولوژی TTL
۶۷	درسنامه (۳): مدارات TTL خاص
۶۷	مدارات کلکتور باز (Open Collector) و سه حالته (Tri-State) تکنولوژی TTL
۶۹	مدارات پرسرعت تکنولوژی TTL
۷۰	مدارات تکنولوژی TTL شاتکی (STTL)
۷۳	مدارات کم‌صرف و پرسرعت تکنولوژی TTL (LSTTL)
۷۴	درسنامه (۴): طراحی و تحلیل مدارات ECL
۷۴	بافر / وارونگر پایه تکنولوژی تزویج امیتری (ECL)
۷۵	پارامترهای عملکردی تکنولوژی ECL
۷۶	دروازه OR / NOR تکنولوژی ECL
۷۷	دروازه AND / NAND تکنولوژی ECL
۷۷	طراحی مدارات منطقی ترکیبی در تکنولوژی ECL
فصل پنجم: ترانزیستورهای اثر بدنی (MOSFET) و وارونگرهای CMOS و NMOS	
۷۹	مقدمه
۷۹	درسنامه (۱): ساختار ترانزیستورهای MOSFET
۸۳	فرایند ساخت ترانزیستورهای MOSFET
۸۶	درسنامه (۲): عملکرد ترانزیستورهای MOSFET
۹۶	پدیده اثر بدنی (Body Effect)
۹۷	درسنامه (۳): انتقال ولتاژ در ترانزیستورهای MOSFET
۱۰۱	درسنامه (۴): مدار پایه تکنولوژی CMOS
۱۰۱	وارونگر تکنولوژی CMOS
۱۰۹	درسنامه (۵): مدار پایه انواع تکنولوژی NMOS
۱۰۹	وارونگر تکنولوژی NMOS مقاومتی
۱۱۳	وارونگر تکنولوژی NMOS افزایشی (Enhancement NMOS)
۱۱۵	وارونگر تکنولوژی شبه (Pseudo NMOS) NMOS
۱۱۶	وارونگر تکنولوژی تخلیمای NMOS (Depletion NMOS)

مدربان شریف



فهرست مطالعه

عنوان	صفحه
درسنامه (۶): فرایند ساخت وارونگرهای CMOS	۱۱۹
پدیده قفل شدگی (Latchup)	۱۲۲
فصل ششم: مدارات ایستا و پویا مبتنی بر MOSFET	
مقدمه	۱۲۳
درسنامه (۱): تکنولوژی‌های مبتنی بر سوئیچینگ	۱۲۴
مدارات منطقی سوئیچینگ	۱۲۴
تکنولوژی ترانزیستورهای عبور (PTL)	۱۲۷
تکنولوژی دروازه انتقال (TG)	۱۳۳
درسنامه (۲): تکنولوژی‌های NMOS و CMOS ایستا	۱۳۷
درسنامه (۳): تکنولوژی‌های پویا CMOS	۱۵۲
درسنامه (۴): تکنولوژی‌های خاص	۱۶۷
تکنولوژی CMOS تفاضلی (Differential CMOS)	۱۶۷
تکنولوژی ترکیبی BiCMOS	۱۶۹
تکنولوژی FGMOS مبتنی بر مقاومت‌های ورودی	۱۷۴
تکنولوژی FGMOS مبتنی بر خازن‌های ورودی	۱۷۵
درسنامه (۵): مدارات کاربردی مبتنی بر MOSFET	۱۷۷
فصل هفتم: پارامترهای ارزیابی کارایی مدارهای دیجیتال	
مقدمه	۱۹۱
درسنامه (۱): خازن و مقاومت لایه‌ای در MOSFET‌ها	۱۹۱
خازن‌های MOSFET	۱۹۱
تخمین ظرفیت خازن‌ها	۱۹۴
تخمین سایز مقاومت‌ها	۱۹۶
درسنامه (۲): تأخیر مدارات دیجیتال	۱۹۹
تأخير در مدل RC (RC-Delay)	۱۹۹
تأخير در وارونگرها و مدارات ترانزیستوری	۲۰۲
محاسبه تأخیرهای زمانی به روش میانگین‌گیری	۲۰۳
درسنامه (۳): توان مصرفی مدارات دیجیتال	۲۰۹
توان مصرفی ایستا و پویا (Static and Dynamic Power)	۲۰۹
توان مصرفی در وارونگرها	۲۱۰
حاصل ضرب توان - تأخیر (Power - Delay Product)	۲۱۳
درسنامه (۴): مساحت مدارات دیجیتال	۲۱۵
سایزیندی ترانزیستورها در مدارات VLSI (Transistor Sizing)	۲۱۵
سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۳	۲۱۹
پاسخنامه آزمون سراسری ۱۴۰۳	۲۲۰
منابع و مراجع	۲۲۲

مدرسان شریف

